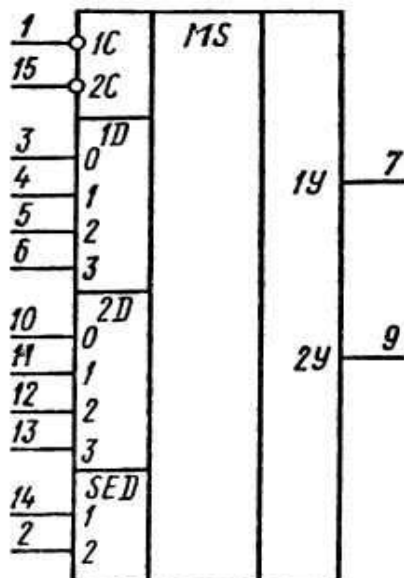


КР1533КП2, КФ1533КП2, ЭКФ1533КП2

Микросхемы представляют собой сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4-1 с общими входами выбора данных и отдельными входами стробирования. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.



Условное графическое обозначение КР1533КП2, КФ1533КП2, ЭКФ1533КП2

Назначение выводов: 1 - вход стробирования $\overline{1C}$; 2 - вход «выбор данных» SED2; 3 - вход информационный 1D0; 4 - вход информационный 1D1; 5 - вход информационный 1D2; 6 - вход информационный 1D3; 7 - выход 1Y; 8 - общий; 9 - выход 2Y; 10 - вход информационный 2D0; 11 - вход информационный 2D1; 12 - вход информационный 2D2; 13 - вход информационный 2D3; 14 - вход «выбор данных» SED1; 15 - вход стробирования $\overline{2C}$; 16 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня ≥ 2,5 В
Ток потребления при $U_n = 5,5$ В ≤ 10 мА
Входной ток низкого уровня:
- по входам 2, 14 ≤ | -0,4 | мА
- по остальным входам ≤ | -0,2 | мА
Входной ток высокого уровня:
- по входам 2, 14 ≤ 40 мкА
- по остальным входам ≤ 20 мкА
Выходной ток | -30 | ... | -112 | мА

Время задержки распространения сигнала при включении:

- по входам 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ≤ 22 нс
- по входам 2, 14 ≤ 28 нс
- по входам 1, 15 ≤ 32 нс

Время задержки распространения сигнала
при выключении:

- по входам 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ≤ 22 нс
- по входам 2, 14 ≤ 36 нс
- по входам 1, 15 ≤ 32 нс

Емкость входа ≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания 4,5...5,5 В

Входное напряжение низкого уровня 0...0,8 В

Входное напряжение высокого уровня 2...5,5 В

Максимальное напряжение, подаваемое на выход 5,5 В

Температура окружающей среды -10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.